

17. R A M

第17章 目次

17.1	概要	609
17.1.1	ブロック図	609
17.1.2	レジスタ構成	610
17.2	システムコントロールレジスタ (SYSCR)	611
17.3	動作説明	612

17.1 概要

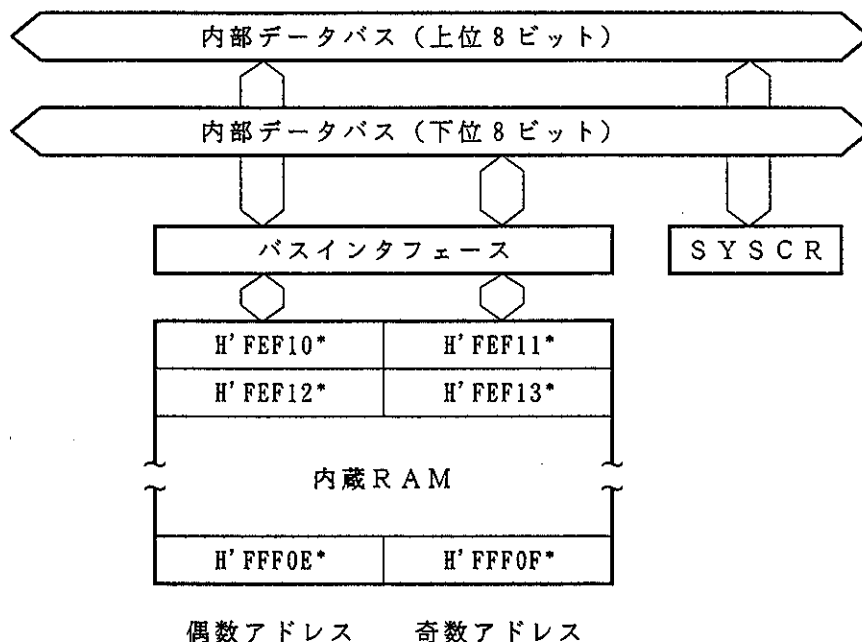
H8/3048、H8/3047は4kバイト、H8/3044、H8/3045は2kバイトのスタティックRAMを内蔵しています。RAMはCPUと16ビット幅のデータバスで接続されており、アクセスはバイトデータ、ワードデータにかかわらず2ステートで行われます。したがって、データの高速度転送が可能です。

H8/3048、H8/3047の内蔵RAMは、モード1、2、5、7のときH'FEF10~H'FFF0Fに、モード3、4、6のときH'FFE10~H'FFF0Fに割り当てられています。

H8/3044、H8/3045の内蔵RAMは、モード1、2、5、7のときH'FF710~H'FFF0Fに、モード3、4、6のときH'FFF710~H'FFF0Fに割り当てられています。システムコントロールレジスタ(SYSCR)のRAMイネーブル(RAME)ビットにより内蔵RAM有効/無効の制御を行います。

17.1.1 ブロック図

RAMのブロック図を図17.1に示します。



《記号説明》

SYSCR : システムコントロールレジスタ

【注】* アドレスは下位20ビットを示しています。また、H8/3048、モード7の場合の例を示しています。

図17.1 RAMのブロック図

17.1.2 レジスタ構成

内蔵RAMは、SYSCRで制御されます。

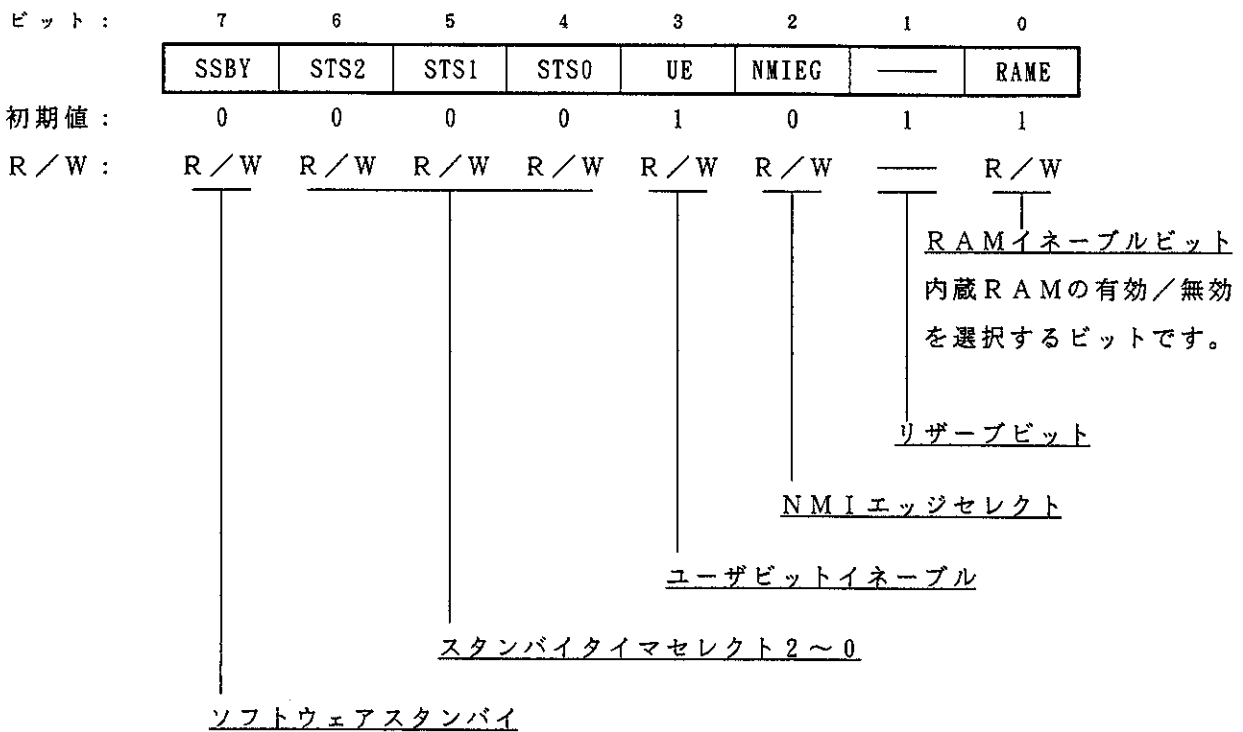
SYSCRのアドレスと初期値を表17.1に示します。

表17.1 レジスタ構成

アドレス*	名 称	略 称	R/W	初期値
H'FFF2	システムコントロールレジスタ	SYSCR	R/W	H'0B

【注】* アドレスは下位16ビットを示しています。

17.2 システムコントロールレジスタ (SYSCR)



SYSCRは、内蔵RAMへのアクセスを許可/禁止するレジスタです。内蔵RAMはSYSCRのRAMEビットにより有効/無効が選択されます。なお、SYSCRのその他のビットについての詳細は「3.3 システムコントロールレジスタ」を参照してください。

ビット0: RAMイネーブル (RAME)

内蔵RAMの有効または無効を選択します。RAMEビットはRES端子の立上がりエッジでイニシャライズされます。ソフトウェアスタンバイモードではイニシャライズされません。

ビット0	説明	
RAME		
0	内蔵RAM無効	
1	内蔵RAM有効	(初期値)

17.3 動作説明

RAMEビットを“1”にセットすると内蔵RAMが有効になります。H8/3048、H8/3047では、モード1、2、5、7のときH'FEF10~H'FFFOFを、モード3、4、6のときH'FFE10~H'FFFFOFをアクセスすると内蔵RAMがアクセスされます。H8/3044、H8/3045では、モード1、2、5、7のときH'FF710~H'FFFOFを、モード3、4、6のときH'FFF710~H'FFFFOFをアクセスすると内蔵RAMがアクセスされます。また、モード1~6（拡張モード）ではRAMEビットが“0”にクリアされているときは、外部アドレス空間がアクセスされます。モード7（シングルチップモード）では、RAMEビットが“0”にクリアされているときは、内蔵RAMはアクセスされません。リードすると常にH'FFがリードされ、ライトは無効です。

RAMはCPUと内部16ビットデータバスで接続されており、ワード単位のリード/ライトが可能です。また、バイト単位のリード/ライトも可能です。

バイトデータは、データバス上位8ビットを使い2ステートでアクセスされ、また、偶数番地から始まるワードデータはデータバス16ビットを使い2ステートでアクセスできます。